

# 2SD1507M 2SD1864

エピタキシャルプレーナ形 NPN シリコントランジスタ  
中電力増幅用/Medium Power Amp.  
Epitaxial Planar NPN Silicon Transistors

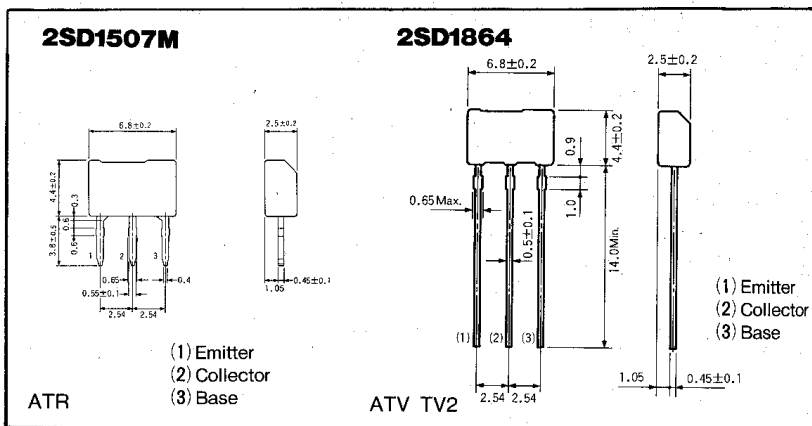
● 特長

- 1)  $V_{CE(sat)}=0.5V$ (Typ.) と低い。  
(at  $I_C/I_B=2A/0.2A$ )
- 2) 2SB1066M/2SB1243 とコンプリ。

● Features

- 1) Low collector saturation voltage:  
 $V_{CE(sat)}=0.5V$ (Typ.),  $I_C/I_B=2A/0.2A$
- 2) Complementary pair with  
2SB1066M, 2SB1243.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



注：ATVの外形仕様については、TV3/4/6タイプも用意しています (p.38参照)。

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ( $T_a=25^\circ C$ )

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	50	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	5	V
コレクタ電流	$I_C$	3	A
		4.5	A (Pulse)
コレクタ損失	$P_C$	1.0	W*
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存温度範囲	$T_{stg}$	-55~150	$^\circ C$

\*プリント基板：  
コレクタ部分の銅箔面積 $1cm^2$ 以上、  
厚み1.7mm

● 電気的特性/Electrical Characteristics ( $T_a=25^\circ C$ )

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$BV_{CEO}$	50	—	—	V	$I_C = 1mA$
コレクタ・ベース降伏電圧	$BV_{CBO}$	60	—	—	V	$I_C = 50\mu A$
エミッタ・ベース降伏電圧	$BV_{EBO}$	5	—	—	V	$I_E = 50\mu A$
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	—	—	1.0	$\mu A$	$V_{CB} = 40V$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	—	—	1.0	$\mu A$	$V_{EB} = 4V$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	1.0	V	$I_C/I_B=2A/0.2A$
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	—	—	1.5	V	$I_C/I_B=2A/0.2A$
直流電流増幅率	$h_{FE}$	56	—	390	—	$V_{CE}/I_C=3V/0.5A$
利得帯域幅積	$f_T$	—	90	—	MHz	$V_{CE} = 5V, I_E = -0.5A$
出力容量	$C_{ob}$	—	40	—	pF	$V_{CB} = 10V, I_E = 0A, f = 1MHz$

$h_{FE}$  の値により下表のように分類します。

Item	N	P	Q	R
$h_{FE}$	56~120	82~180	120~270	180~390

● 標準品・準標準品一覧表

(◎ : 標準品 ○ : 準標準品)

Type	$h_{FE}$	包装名	バルク	コンテナ	テーピング	
		記号		C2	TV2	TV3
2SD1507M	NPQR	基本発注単位(個)	1 000	4 000	2 500	2 500
2SD1864	NPQR		—	—	◎	○